

1.形名 RTU002P02

2.構造 シリコンPチャンネルMOS型電界効果トランジスタ

3.用途 スイッチング

4.絶対最大定格 [Ta=25]

ドレイン・ソース間電圧		V _{DSS}	...	-20V	
ゲート・ソース間電圧		V _{GSS}	...	±12V	
ドレイン電流	直流	I _D	...	±0.25A	
	パルス	I _{DP}	...	±0.5A	PW 10μs DUTY CYCLE 1%
全許容損失		P _D	...	0.2W	各端子を推奨ランドに 実装した場合
チャンネル部温度		T _{ch}	...	150	
保存温度		T _{stg}	...	-55~150	

5.熱抵抗

チャンネル・外気間	R _{th(ch-a)}	...	625 /W	各端子を推奨ランドに 実装した場合
-----------	-----------------------	-----	--------	----------------------

DESIGN	CHECK	APPROVAL	DATE : 27/JAN/2003	SPECIFICATION No. TSQ03025H-126
			REV. : 0	ROHM CO., LTD.

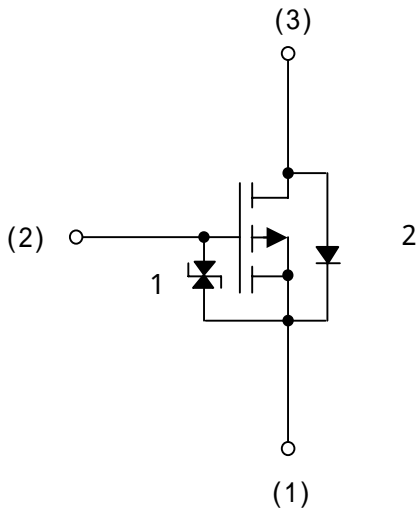
6. 電気的特性 [Ta=25]

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値
ゲート漏れ電流	I _{GSS}	VGS=±12V / VDS=0V	-	-	±10μA
ドレイン・ソース降伏電圧	V(BR) _{DSS}	ID=-1mA / VGS=0V	-20V	-	-
ドレイン遮断電流	I _{DSS}	VDS=-20V / VGS=0V	-	-	-1μA
ゲートしきい値電圧	VGS(th)	VDS=-10V / ID=-1mA	-0.7V	-	-2.0V
ドレイン・ソース間オン抵抗	RDS(on) * パルス	ID=-0.25A VGS=-4.5V	-	1.0	1.5
		ID=-0.25A VGS=-4V	-	1.1	1.6
		ID=-0.15A VGS=-2.5V	-	2.0	3.0
順伝達アドミタンス	Y _{fs} * パルス	VDS=-10V ID=-0.15A	0.2S	-	-
入力容量	C _{iss}	VDS=-10V / VGS=0V f=1MHz	-	50pF	-
出力容量	C _{oss}		-	5pF	-
帰還容量	C _{rss}		-	5pF	-
ターンオン遅延時間	t _{d(on)} * パルス	ID=-0.15A VDD -15V VGS=-4.5V RL=100 RGS=10	-	9ns	-
上昇時間	t _r * パルス		-	6ns	-
ターンオフ遅延時間	t _{d(off)} * パルス		-	35ns	-
下降時間	t _f * パルス		-	45ns	-

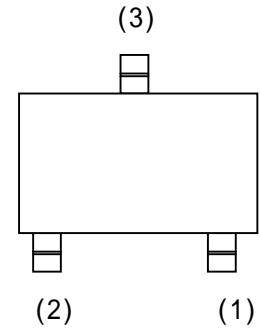
内部ダイオード特性 (ソース・ドレイン間)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値
順方向電圧	VSD	IS=-0.1A / VGS=0V	-	-	-1.2V

7. 内部回路

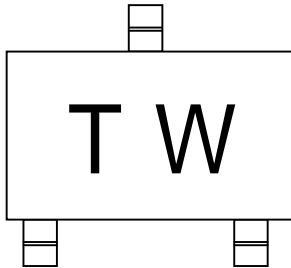


- (1) ソース
- (2) ゲート
- (3) ドレイン



- 1 静電気保護用ダイオード
- 2 内部ダイオード

8. 標印



“ T W ” は “ RTU002P02 ” を表す略記号です。